Облікова картка ДіР

Image not found or type unknow

I. Загальні відомості

Державний обліковий номер: 0305U001257

Державний реєстраційний номер: 0104U000893

Особливі позначки: відкрита

Дата реєстрації: 31-01-2005

II. Етап виконання ДіР

Номер етапу: 1

Назва етапу: Вирощування нелегованих і легованих кристалів CdxZn1-xTe методом сублімації

Початок етапу: 01.2001

Закінчення етапу: 12.2002

Вид звітного документа: Без звіту

III. Відомості про виконавця ДіР

Повне найменування юридичної особи (або ПІБ фізичної особи): Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка

Код за ЄДРПОУ: 02125438

Місцезнаходження:

Форма власності:

Сфера управління: Міністерство освіти України

Ідентифікатор ROR: Не застосовується

Розмір організації:

Телефон: (03-244)3-33-32,3-81-11

IV. Відомості про співвиконавців ДіР

V. Відомості про замовника ДіР

Повне найменування юридичної особи (або ПІБ фізичної особи): Міністерство освіти і науки України

Код за ЄДРПОУ: 00026777

Місцезнаходження: , м. Київ, Київ, 01135, Україна

Форма власності:

Сфера управління: Кабінет Міністрів України

Ідентифікатор ROR: Не застосовується

Розмір організації:

Телефон: www.mon.gov.ua

VI. Джерела, напрями та обсяги фінансування ДіР

Підстава для проведення ДіР: 34 - договір (замовлення) з центральним органом виконавчої влади, академією наук (головними розпорядниками бюджетних коштів на проведення НДДКР)

Напрям фінансування:

Джерела фінансування

VII. Відомості про ДіР

Назва роботи українською:

Дослідження процесів деградації напівпровідникових твердих розчинів CdxZn1-xTe

Назва роботи англійською:

The investigation of processes of degradation of semi-conductor solid solutions CdxZn1-xTe

Реферат українською:

Напівпровідники CdTe, а також CdxZn1-xTe вже знайшли своє використання в електронній техніці. Тому важливим є технологія отримання цих матеріалів з мінімально можливою концентрацією власних дефектів. Метою роботи - дослідження впливу температури термообробки на структуру дефектів в CdxZn1-xTe, дослідження можливості пасивації дрібних дефектів воднем. Методи дослідження - дослідження електрофізичних властивостей в температурному інтервалі 77 - 300 К, статистичний аналіз електричних характеристик вирощених кристалів. Основні результати - удосконалення методики вирощування CdxZn1-xTe, отримання енергетичної картини дефектів. За спектрами фотолюмінісценції найменш дефектними виявились кристали CdxZn1-xTe, вирощені із шихти, синтезованої у водні Фізика напівпровідників.

Реферат англійською:

The semiconductors such as CdTe and CdxZn1-xTe have alredy found their application in electronics. So the technology of producing these materials with minimal concentration of native defects is important. The purpose of the work is to study the influence of heat tretment temperature on the defective structure in CdxZn1-xTe and the possibility of passivation of shollow defects by hydrogen. The research techniques are the investigation of electrofisical properties in the temperature range of 77 - 300 K and the statistical analysis of electrical characteristics of grown crystals. The main results are the modification of CdxZn1-xTe growth technology and obtaining the energy scheme of defects. From the photoluminescence spectra CdxZn1-xTe crystals grown by charge, synthesized in hydrogen, are less defective. Physics of semiconductors.

Індекс УДК: 535, 681.51;616.6

Коди тематичних рубрик: 29.31.01

Керівники роботи

Власне Прізвище Ім'я По-батькові: Пелещак Р.М.

Науковий ступінь:

Вчене звання:

Ідентифікатор ORCID ID:

Додаткова інформація:

VIII. Наукова (науково-технічна) продукція (НТП)

IX. Бібліографічний опис

Британ В., Попович В., Цюцюра Д., Шкумбатюк П. "Вирощування та дефектність CdxZn1-xTe". // Фізичний збірник НТШ, 2002, т.5. - С.12-15. Британ В.Б., Цюцюра Д.І., Пігур О.М., Ковальчук І.В.(1), Денис Р.В.(1), Крилюк С.Г.(2) "Про домішково-дефектні стани в CdxZn1-xTe, вирощених у різних умовах" //Вісник ДУ "Львівська політехніка". Електроніка. - 2004. - №513. - С. 67-70.

X. Заключні відомості

Керівник юридичної особи Скотний В.Г.

Перелік осіб-виконавців

Відповідальний за підготовку облікових документів

Телефон

Реєстратор

Керівник відділу УкрІНТЕІ, що є відповідальним за реєстрацію наукової діяльності

